

SiC SBD & SiC MOSFET

2015年推出了650V和1200V的SBD二极管系列以及1200V常开型SiC MOSFET。
第二代650V SBD二极管系列即将上市。

器件	V _{RRM} 或 V _{DSS}	工艺	2014	2015		2016	
			2H	1H	2H	1H	2H
SBD	650V	一代	产品线 I _F =6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 24A TO-220-2L  TO-220F-2L  TO-247 				
		二代	理念 低导通电阻 高浪涌电流 				
	1200V	一代	1200V / 20A TO-3P (N) 				
MOSFET	1200V	一代	 1200V / 69mΩ TO-3P (N) 				

碳化硅SBD系列产品线

I _F (A V)	一代				二代		
	650V			1200V	650V		
	TO-220-2L 	TO-220F-2L 	TO-247 	TO-3P (N) 	TO-220-2L 	TO-220F-2L 	DPAK 
2A					TRS2E65F		TRS2P65F
3A					TRS3E65F		TRS3P65F
4A					TRS4E65F	TRS4A65F	TRS4P65F
6A	TRS6E65C	TRA6A65C			TRS6E65F	TRS6A65F	TRS6P65F
8A	TRS8E65C	TRA8A65C			TRS8E65F	TRS8A65F	TRS8P65F
10A	TRS10E65C	TRS10A65C			TRS10E65F	TRS10A65F	TRS10P65F
12A	TRS12E65C	TRS12A65C	TRS12N65D				
16A		TRS16A65C	TRS16N65D		TRS***: sample stage		
20A			TRS20N65D	TRS20J120C	TRS***: '2Q / 16 sample		
24A			TRS24N65D		TRS***: under-considering		

